

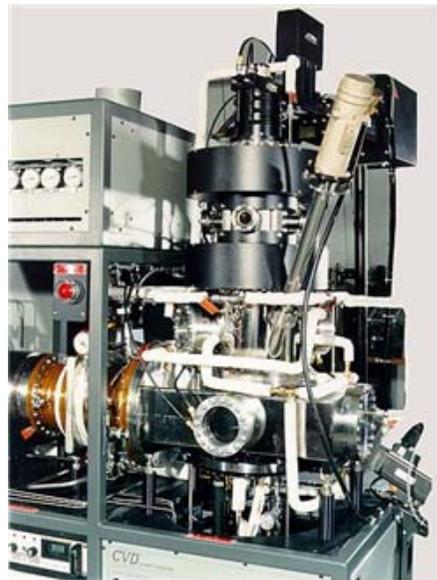
(4) プラズマ増殖型化学的気相成長装置

品目	プラズマ増殖型化学的気相成長装置 Plasma enhanced Chemical Vapour Deposition (CVD) equipment
WA List	3. B. 1. d
項番等	7の項(16) 省令第6条第十七号の二
規制理由	化学的気相成長(CVD)装置は、半導体ウエハー上に薄膜を形成するために用いられる装置で、軍用半導体の製造に用いられる。



Plasma enhanced chemical vapor deposition equipment

プラズマ増殖型
化学的気相成長装置



Chemical vapor deposition equipment

化学的気相成長装置

【補足解説】

化学気相成長（CVD）法は、ウエハーに付着させる材料の反応性ガスをチャンバー内に流し、CVD反応の励起エネルギーとしてプラズマや熱のエネルギーを使ってウエハー上に薄膜を形成させる方法である。